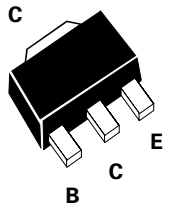
SOT89 NPN SILICON PLANAR HIGH VOLTAGE TRANSISTOR

ISSUE 3 – JANUARY 1996 ✪

SXTA42

COMPLEMENTARY TYPE – SXTA92

PARTMARKING DETAIL – SID



SOT89

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	300	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	300	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	6	V
Continuous Collector Current	I_C	500	mA
Power Dissipation at T_{amb}=25°C	P_{tot}	1	W
Operating and Storage Temperature Range	T_j:T_{stg}	-65 to +150	°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at T_{amb} = 25°C).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	300			V	I_C=100μA, I_E=0
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	300			V	I_C=1mA, I_B=0*
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	6			V	I_E=100μA, I_C=0
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}			0.1	μA	V_{CB}=200V, I_E=0
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}			0.1	μA	V_{EB}=6V, I_C=0
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$			0.5	V	I_C=20mA, I_B=2mA*
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$			0.9	V	I_C=20mA, I_B=2mA*
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	25 40 40				I_C=1mA, V_{CE}=10V* I_C=10mA, V_{CE}=10V* I_C=30mA, V_{CE}=10V*
Transition Frequency	f_T	50			MHz	I_C=10mA, V_{CE}=20V f=20MHz
Output Capacitance	C_{obo}			6	pF	V_{CB}=20V, f=1MHz

*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300μs. Duty cycle ≤2%
For typical characteristics graphs see FMMTA42 datasheet.

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9